

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第16卷 第3期 1995年3月

目 次

- 多量子阱光波导传输特性分析 马春生 (161)
- 在微重力下生长的 GaAs:Si 单晶结构缺陷的 X 射线研究 蒋四南 林兰英 (167)
- 高精度双晶衍射(HRDCD)方法检测 InGaAs/GaAs 超薄应变层量子阱结构参数·····
..... 王小军 庄岩 王玉田 庄婉如 王启明 黄美纯 (170)
- 多孔硅的椭偏光谱研究 莫党 周光增 林位株 张树霖 蔡生民 (177)
- MBE 生长的 p-Hg_{1-x}Cd_xTe 外延薄膜变磁场下的 Hall 系数及电导率·····
..... 杜庆红 何力 袁诗鑫 C. R. Becker G. Laudwehr (182)
- 半导体材料与器件生产工艺尾气中砷、磷、硫的治理及检测·····
..... 闻瑞梅 梁骏吾 邓礼生 彭永清 (188)
- Co-Si 界面低温(≤450℃)相变的电子显微术研究 张灶利 肖治纲 杜国维 (195)
- TW-SLA 在耦合腔锁模激光器中的调制特性 孙军强 黄德修 李再光 (201)
- 硅膜厚度和背栅对 SIMOX/SOI 薄膜全耗尽 MOSFET 特性影响的研究
..... 魏丽琼 程玉华 孙玉秀 阎桂珍 李映雪 武国英 王阳元 (206)
- 一种新的模块自动生成技术及其系统 蔡懿慈 洪先龙 (212)
- 一个以时延优化为目标的力指向 Steiner 树算法 洪先龙 (218)
- GTR 多环 FLR 结构优化 荆春雷 肖浦英 陈治明 (224)
- 用强流金属离子源研究 Ti-Si 化合物的形成 朱德华 卢红波 柳百新 (229)
- 采用 SiO₂/Si 系扩镓提高扩散质量和器件性能的研究·····
..... 刘秀喜 赵富贤 薛成山 孙瑛 华士奎 (235)